

インド半導体産業支援策「Semicon 2.0」について

2026 年 8 月 31 日時点

柱	カテゴリー	対象分野	対象事業者・応募資格	支援内容
1. 半導体設計	【カテゴリー 1】 国家重要分野および戦略優先分野向け半導体 IP・チップ・SoC・モジュールの設計	- IP コア - チップ - SoC (System-on-Chip) - 電子機器向けモジュールの設計および開発	(1) 以下のいずれも満たす企業 - インドで設立され本社を置いていること - インド国内に十分な事業基盤および人員体制を有すること - インド市民が所有・経営権を有すること (2) 以下の企業・団体とのコンソーシアムによる応募も可 - 外国企業 - 研究開発機関 - 大学などの学術機関	先端コンピューティング開発センター（C-DAC）が発行する提案依頼書に基づいて競争入札が行われ、技術面・財務面から評価された承認条件に従って支援金が支給される。
	【カテゴリー 2】 商業分野向け半導体 IP・チップ・SoC の設計	- IP - チップ - SoC の設計および開発	(1) 以下のいずれも満たす企業 - インドで設立され本社を置いていること - インド国内に十分な事業基盤および人員体制を有すること - インド市民または海外インド系市民が所有・経営権を有すること (2) 以下の企業・団体とのコンソーシアムによる応募も可 - 外国企業 - 研究開発機関 - 大学などの学術機関	(1) 設計インフラ支援 【対象】 インド国内大学、スタートアップ、零細中小企業 - 国家 EDA ツール基盤への一元的なアクセス - MPW 試作サービスへの一元的なアクセス 【対象】 左記 (1), (2) に該当する事業者 - 半導体 IP コアの利用 - 演算サブシステム（CSS）の利用 - ポストシリコン検証サービスへのアクセス (2) 製品設計連動型インセンティブ 【対象】 スタートアップ、零細中小企業 - シード資金：プロジェクト費用の 50%または 1.5 億ルピーのいずれか低い額をマイルストーン連動で提供。

				- 共同出資：VC または PE から資金調達した企業に対し、同条件で政府が共同出資を行う。 【対象】企業（スタートアップ、零細中小企業を除く） - ロイヤルティ融資 政府が共同出資し、支援額の 1.5 倍が回収されるまで、製品売上の 5%をロイヤリティとして支払う。 - 共同出資：VC または PE から資金調達した企業に対し、同条件で政府が共同出資を行う。															
	【カテゴリー 3】 半導体 IP・チップ・SoC の導入に対する導入連動型インセンティブ	本制度の発表後に初めて市場投入される半導体 IP コア・チップ・SoC であり、制度発表以前に販売実績がないものの。	【カテゴリー1】 および【カテゴリー2】の応募資格を満たす事業者は、本カテゴリーにも申請可	対象製品の純売上高に対して、5 年間にわたり 9%を還付 ただし、 - 申請案件当たりの支援上限：3 億ルピー - 企業グループ全体での支援上限：12 億ルピー															
2. 製造装置・材料	【カテゴリー 4】 半導体製造エコシステム	以下の施設・装置の設置を対象とする。 (1) 半導体製造装置の研究開発施設 (2) 半導体製造向け原材料の製造施設（ウェハー、フォトマスク、フォトレジスト、基板、化学品、ガス、ディスプレイ製造用ガラスなど） (3) 半導体試験・特性評価施設	- 提案する事業に必要な自社技術もしくはライセンス取得済み技術を保有していること（試験・特性評価施設を除く）。 - 左記 (1) ～ (4)の対象サブ分野ごとの最低投資額および最低売上高は以下のとおり <table><tr><td></td><td>最低投資額</td><td>最低売上高</td></tr><tr><td>(1)</td><td>30 億ルピー</td><td>12 億ルピー</td></tr><tr><td>(2)</td><td>5 億ルピー</td><td>2 億ルピー</td></tr><tr><td>(3)</td><td>10 億ルピー</td><td>4 億ルピー</td></tr><tr><td>(4)</td><td>30 億ルピー</td><td>12 億ルピー</td></tr></table>		最低投資額	最低売上高	(1)	30 億ルピー	12 億ルピー	(2)	5 億ルピー	2 億ルピー	(3)	10 億ルピー	4 億ルピー	(4)	30 億ルピー	12 億ルピー	(1) ～ (3) について 設備投資額の 30%を補助 (4) について (i) 設備投資額の 30%を補助 (ii) インド国内製造業者から調達した部材評価額を基準として生産連動型インセンティブ（PLI）を付与 PLI 率 - 1 年目：10% - 2 年目：8% - 3 年目：6%
	最低投資額	最低売上高																	
(1)	30 億ルピー	12 億ルピー																	
(2)	5 億ルピー	2 億ルピー																	
(3)	10 億ルピー	4 億ルピー																	
(4)	30 億ルピー	12 億ルピー																	

		(4) 半導体製造およびパッケージング工場で使用される製造/組み立て装置、再生装置、組み立てユニットおよび構成部品の製造/組み立て装置		- 4 年目：4% - 5 年目：2% *2028 年度から 5 年間適用され、総支援額は適格設備投資額の 50%を上限とする。
3. 前工程工場の設立	【カテゴリー 5】 シリコン半導体ウェハー工場	シリコン半導体ウェハー工場の設立	- ウェハーサイズ：300mm - 生産能力：月産 40,000 枚以上 - 操業実績：量産対応の自社技術またはライセンス取得済み技術を保有していること - 最低投資額：2,000 億ルピー - 最低売上高：750 億ルピー	適格設備投資額の 40%を補助
	【カテゴリー 6】 化合物半導体工場、フォトニクス工場、センサー（MEMS 含む）工場、ディスクリート半導体工場	化合物半導体工場、フォトニクス工場、センサー（MEMS 含む）工場、ディスクリート半導体工場の設立	- ウェハーサイズ： (i) センサー（MEMS 含む）：200mm 以上 (ii) 化合物半導体・ディスクリート半導体：150mm 以上 (iii) フォトニクス：100mm 以上 - 生産能力：月産 500 枚以上 - 操業実績：量産対応の自社技術またはライセンス取得済み技術を保有していること - 最低投資額：50 億ルピー - 最低売上高：20 億ルピー	適格設備投資額の 35%を補助

	【カテゴリー 7】 ディスプレイ工場	以下の技術を用いたディスプレイ工場の設立 - OLED - Micro LED - LCD	<table><tr><td></td><td>OLED</td><td>Micro LED</td><td>LCD</td></tr><tr><td>生産能力</td><td>月産 30,000 パネル以上</td><td>月間 500 m² 以上のパネル面積</td><td>月産 60,000 パネル以上</td></tr><tr><td>最低投資額</td><td>1,000 億ルピー</td><td>150 億ルピー</td><td>1,000 億ルピー</td></tr><tr><td>最低売上高</td><td>500 億ルピー</td><td>60 億ルピー</td><td>500 億ルピー</td></tr></table>		OLED	Micro LED	LCD	生産能力	月産 30,000 パネル以上	月間 500 m ² 以上のパネル面積	月産 60,000 パネル以上	最低投資額	1,000 億ルピー	150 億ルピー	1,000 億ルピー	最低売上高	500 億ルピー	60 億ルピー	500 億ルピー	適格設備投資額の 35%を補助
	OLED	Micro LED	LCD																	
生産能力	月産 30,000 パネル以上	月間 500 m ² 以上のパネル面積	月産 60,000 パネル以上																	
最低投資額	1,000 億ルピー	150 億ルピー	1,000 億ルピー																	
最低売上高	500 億ルピー	60 億ルピー	500 億ルピー																	
4. 後工程産業 の強化	【カテゴリー 8】 半導体組み立て・試験・マーキング・パッケージング (ATMP)、外部委託半導体組み立て・試験 (OSAT) 施設	ATMP 施設、OSAT 施設の設立	(1) 先進パッケージング (2.5D / 3D パッケージング、ウエハーレベル・チップスケール・パッケージング、異種集積) および先進基板 - 操業実績：量産対応の自社技術またはライセンス取得済み技術を保有していること - 最低投資額：100 億ルピー以上 - 最低売上高：グループ会社または合併会社を含め、20 億ルピー以上 (申請年度以前の直近 3 会計年度のいずれか 1 年度において) (2) 従来型パッケージング - 操業実績：量産対応の自社技術またはライセンス取得済み技術を保有していること - 最低投資額：100 億ルピー以上 - 最低売上高：グループ会社または合併会社を含め、20 億ルピー以上 (申請年度以前の直近 3 会計年度のいずれか 1 年度において)	(1) 適格設備投資額の 35%を補助 (2) 適格設備投資額の 25%を補助																

5. 研究開発	【カテゴリー 9】 先端半導体技術の研究開発	- CMOS ベースの半導体製造に関する先端プロセス技術 - シリコンフォトニクス - ディスプレイ製造技術 - 先進パッケージング向けチップレット技術 - その他の先端半導体関連技術の開発	半導体企業単独での応募に加え、大学などの学術機関・研究開発機関などとのコンソーシアムによる応募も可。	プロジェクト費用（設備投資費用および運営費用）の最大 75%まで支援を受けることができる（州政府による支援もこの 75%に含まれる）。 また、必要に応じて「研究・開発・イノベーションスキーム」による部分的な資金支援を組み合わせることも可能。
6. 人材育成	【カテゴリー 10】 人材育成 *対象となる人材 - 学部学生 - 大学院生 - 博士課程学生 - 工場現場の技術者・オペレーター	(1) 設計分野 先端的なチップ設計ツール、マルチプロジェクトウェハー試作サービス、ポストシリコン検証ツールなどへのアクセス提供ならびに人材育成プロジェクトの実施支援 (2) 製造分野 - 工場現場人材への実践的な訓練を実施するための専用教育・訓練インフラの整備・支援、既存インフラの活用・支援 - 産業界のニーズに即した実践的な教育訓練を提供するための国家ナノファブリケーション施設およびプロセス研究施設の機能強化	- インド国内の大学などの学術機関 - 研究開発機関・研究所 - 学術団体 - 国内の教育・研修機関	プロジェクト費用（設備投資費用および運営費用）の最大 75%まで支援を受けることができる（州政府による支援もこの 75%に含まれる）。

（出所）インド電子情報技術省の 2026 年 8 月 31 日付通知文書を基にジェトロ作成